世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 C07D 239/90, 239/91

(11) 国際公開番号 A1

WO97/08153

(43) 国際公開日

1997年3月6日(06.03.97)

(21) 国際出願番号

PCT/JP96/02388

(22) 国際出願日

1996年8月26日(26.08.96)

(30) 優先権データ

特願平7/221518

1995年8月30日(30.08.95)

特願平7/232146

1995年9月11日(11.09.95)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

株式会社 大塚製薬工場

(OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.)[JP/JP]

〒772 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115 Tokushima, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

宮田一義(MJYATA, Kazuyoshi)[JP/JP]

〒772 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端南58-1

ライトビル302号 Tokushima, (JP)

黑木保久(KUROGI, Yasuhisa)[JP/JP]

〒772 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚189-5

ヴィラセゾン205号 Tokushima, (JP)

堺 恭大(SAKAI, Yasuhiro)[JP/JP]

〒779-02 徳島県鳴門市大麻町桧字東バリ31 Tokushima, (JP)

津田可彦(TSUDA, Yoshihiko)[JP/JP]

〒772 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜127 Tokushima, (JP)

(74) 代理人

弁理士 三枝英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.) 〒541 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1

北浜TNKピル Osaka, (JP)

(81) 指定国 AU, CA, CN, JP, KR, US.

添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING QUINAZOLIN-4-ONE DERIVATIVES

(54)発明の名称 キナゾリン-4-オン誘導体の製造方法

(57) Abstract

A novel process comprising cyclizing a compound represented by general formula (1), wherein R^1 , R^2 , R^3 and R^4 are the same or different and each represents hydrogen, lower alkyl, etc.; R^5 represents phenyl, etc.; and R^6 represents lower alkyl, etc., by treating with a halogenated trialkylsilane in the presence of a base to thereby give a series of quinazolin-4-one derivatives represented by general formula (2), wherein R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 and R^6 are each as defined above, which are useful as drugs and intermediates in the synthesis thereof in a high yield while suppressing the formation of by-products.

$$R^{2}$$
 R^{1}
 $NH-R^{5}$
 R^{6}
 R^{2}
 R^{6}

4

2

,/ ;# (57) 要約

本発明は、一般式

$$R^2$$
 R^3
 R^4
 $NH-R^5$
 R^6

 C_{Λ}

[式中R'、R'、R'及びR'は同一又は異なって水素原子、低級アルキル基他を、R'はフェニル基他を、R'は低級アルキル基他をそれぞれ示す。]

で表される化合物に、塩基の存在下、ハロゲン化トリアルキルシランを作用させて環化反応を行うことを特徴とする、一般式

$$R^{2}$$

$$R^{3}$$

$$R^{4}$$

$$R^{5}$$

$$R^{6}$$

[式中R'、R'、R'、R'、R'及びR'は上記に同じ。] で表される、医薬品乃至その合成中間体として有用な一連のキナゾリン-4-オン誘導体を、高収率で且つ副生成物の生成を抑制して製造可能とする新しい方法を提供する。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

明細書

キナゾリン-4-オン誘導体の製造方法

技 術 分 野

本発明は、キナゾリン-4-オン誘導体、特に糖尿病 5 治療剤等の医薬化合物の合成中間体として、或いはそれ 自体糖尿病治療剤有効成分として有用な、新しいキナゾ リン-4-オン誘導体の製造方法に関する。

従 来 技 術

従来よりキナゾリン-4-オン誘導体の製造方法とし
10 ては、例えばJ. Org. Chem. , 41 (10),
1763(1976)に記載の方法が、一般に知られて
いる。該方法は、ジアミド誘導体を加熱して環化するも
のであるが、加熱温度が250℃以上と高温であるため、
得られるキナゾリン-4-オン誘導体の収率が極めて低
15 くなり、副生成物も多くなる欠点がある。

従って、本発明の目的は医薬品乃至その合成中間体として有用な一連のキナゾリンー4ーオン誘導体を、より高収率で且つ副生物の生成を抑制して、製造可能とする新しい方法を提供することにある。

20 本発明者らは、鋭意研究の結果、上記目的が下記方法 により達成されることを見いだし、ここに本発明を完成 するに至った。

発明の開示

即ち、本発明は、一般式

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & NH - R^5 \\
\hline
 & NH - R^5 \\
\hline
 & R^6 \\
\hline
 & R^6
\end{array}$$
(1)

〔式中R¹、R²、R³及びR⁴は同一又は異なって水素原 子、低級アルキル基、ハロゲン原子、ニトロ基、低級 アルコキシ基、シアノ基、N-低級アルキルカルバモ 10 イル基、低級アルコキシカルボニル基又はハロゲン置 換低級アルキル基を、R5は置換基として低級アルキル 基、低級アルコキシ基及びハロゲン原子から選ばれる 基の1~3個を有することのあるフェニル基、低級ア 15 ルキル基、フェニル環上に置換基としてハロゲン原子 を有することのあるフェニル低級アルキル基、低級ア ルケニル基、低級アルコキシ低級アルキル基又は低級 アルキニル基を、R⁶は低級アルキル基、ハロゲン置換 低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基又は置 20 換基として低級アルキル基もしくは基

$$-A-Z-P < 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ R^{8}$$

(式中Aは酸素原子又は単結合を、 2 は低級アルキレン基を、 R 7 は低級アルキル基を、 R 8 は低級アルコキシ基、 フェニル基又はフェニル環上にハロゲン原子を有することのあるフェニル低級アルコキシ基を表す)を有することのあるフェニル基をそれぞれ示す。〕で表される化合物に、塩基の存在下、ハロゲン化トリアルキルシランを作用させて環化反応を行なうことを特徴とする、一般式

〔式中R¹、R²、R³、R⁴、R⁵及びR°は上記に同じ。〕15 で表されるキナゾリン-4-オン誘導体の製造方法に係わる。

一特に、本発明によれば、塩基が3級アミンである上記 方法、ハロゲン化トリアルキルシランがクロロトリアル キルシランである上記方法、塩基及びハロゲン化トリア ルキルシランの使用量がそれぞれ3~20当量である上 記方法、及び反応温度が0~100℃である上記方法が 提供される。 本発明方法により提供されるキナゾリン-4-オン誘導体を表わす上記一般式において、R¹~R°で定義される各基としては、次の各基を例示できる。即ち、ハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原5 子、ヨウ素原子を、低級アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、バキシ、キシ基等を、低級アルキル基としては、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、はert-ブチ10 ル、ペンチル、ヘキシル基等を、それぞれ例示できる。

フェニル環上に置換基としてハロゲン原子を有することのあるフェニル低級アルキル基としては、例えばベンジル、α-フェネチル、β-フェネチル、1-フェニルプロピル、2-フェニルプロピル、3-フェニルプロピル、6-フェニルベキシル、2-ブロモベンジル、3-ブロモベンジル、4-ブロモベンジル、4-ブロモベンジル、2-ブロモベンジル、2-ブロモベンジル、2-ブロモベンジル、2-ブロモベンジル、2-ブロモベンジル、2-ブロー4-フルオロベンジル、2-ブロモー4-クロロベンジル、2-ブロモー4-クロロベンジル、2-ブロモー4-クロロベンジル、2-ブロモー4-クロロベンジル、2-ブロモー4-クロロベンジル、2-ブロモー4-クロロベンジル、2-ブロモー4-クロロベ

ンジル、2-クロロ-4-ブロモベンジル、2-ヨード

- 4 - ブロモベンジル、 3 - クロロー 5 - ブロモベンジル、 3 - ブロモー 5 - フルオロベンジル、 3 - クロロー 5 - フルオロベンジル、 3 - クロロー ル、 3 - クロロー 5 - ヨード - 5 - ブロモベンジル、 3 - クロロー 5 - ヨードベンジル基等を例示できる。

- 低級アルケニル基としては、例えばビニル、1-メチルビニル、1-プロペニル、2-プロペニル、1-ブテニル、2-ブテニル、2, 2-ジメチルビニル、1-ペンテニル、2-ペンテニル、3-ペンテニル、4-ペンテニル、1-ヘキセニル、2-ヘキセニル、3-ヘキセニル、4-ヘキセニル、5-ヘキセニル基等を例示できる。
- ハロゲン置換低級アルキル基としては、例えばトリフルオロメチル、ペンタフルオロエチル、ヘプタフルオロ プロピル、ノナフルオロブチル、ウンデカフルオロペン チル、トリデカフルオロヘキシル、クロロメチル、ブロモメチル、ヨードメチル、2-クロロエチル、3-クロロプチル、6-クロロヘキシル基等を例示できる。

低級アルコキシ低級アルキル基としては、例えばメト 20 キシメチル、エトキシメチル、プロポキシメチル、ブト キシメチル、ペンチルオキシメチル、ヘキシルオキシメ チル、2-メトキシエチル、3-メトキシプロピル、4

15

20

-メトキシブチル、5-メトキシペンチル、6-メトキ シヘキシル基等を例示できる。

低級アルキニル基としては、例えばエチニル、2-プロピニル、3-ブチニル、4-ペンチニル、5-ヘキシニル基等を例示できる。

フェニル環上にハロゲン原子を有することのあるフェニル低級アルコキシ基としては、例えばベンジルオキシ、2-フェニルエトキシ、3-フェニルプロポキシ、4-フェニルブトキシ、5-フェニルペンチルオキシ、6-フェニルヘキシルオキシ、4-クロロベンジルオキシ、3-クロロベンジルオキシ、2-クロロベンジルオキシ、4-ブロモベンジルオキシ基等を例示できる。

低級アルキレン基としては、例えばメチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン基等を例示できる。

N-アルキルカルバモイル基としては、例えばN-メチルカルバモイル、N-エチルカルバモイル、N-プロピルカルバモイル、N-ブチルカルバモイル、N-ペンチルカルバモイル、N-ペキシルカルバモイル基等を例示できる。

低級アルコキシカルボニル基としては、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボ

ニル、プトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボニル、 ヘキシルオキシカルボニル基等を例示できる。

低級アルカノイルオキシ基としては、例えばアセトキシ、プロピオニルオキシ、ブチリルオキシ、バレリルオキシ、ピバロイルオキシ、ヘキサノイルオキシ、ヘプタノイルオキシ基等を例示できる。

置換基として低級アルキル基、低級アルコキシ基及び
ハロゲン原子から選ばれる基の1~3個を有することの
あるフェニル基としては、フェニル基に加えて、例えば
10 2 - メチルフェニル、3 - メチルフェニル、4 - メチル
フェニル、4 - エチルフェニル、4 - プロピルフェニル、
4 - ブチルフェニル、4 - ペンチルフェニル、2, 4 - ジ
メチルフェニル、3, 4 - ジメチルフェニル、3, 4,
15 5 - トリメチルフェニル、2 - クロロフェニル、3 - クロフェニル、4 - フロフェニル、4 - ブロモフェニル、4 - コードフェニル、4 - フルオロフェニル、2,
4 - ジクロロフェニル、2, 4, 6 - トリクロロフェニ

20 -メトキシフェニル、4-エトキシフェニル、4-プロポキシフェニル、4-ブトキシフェニル、4-ペンチルオキシフェニル、2.3

ル、2-メトキシフェニル、3-メトキシフェニル、4

-ジメトキシフェニル、2, 4-ジメトキシフェニル、3, 4-ジメトキシフェニル、3, 4, 5-トリメトキシフェニル、4-クロロ-2-メチルフェニル、2-クロロ-4-メチルフェニル、4-メトキシー3-メチルフェニル、3-メトキシー4-メチルフェニル、4-クロロ-2-メトキシフェニル、2-クロロ-4-メトキシフェニル、3, 5-ジーt-ブチル-4-メトキシフェニル基等を例示できる。

また、Rfで定義される基の内で、前述した置換基を 有することのあるフェニル基としては、フェニル基に加 10 えて、例えば2-メチルフェニル、3-メチルフェニル、 4-メチルフェニル、4-エチルフェニル、4-プロピ ルフェニル、4-ブチルフェニル、4-ペンチルフェニ ル、4-ヘキシルフェニル、4-〔(ジエトキシホスホ リル) メチル〕フェニル、3-〔(ジエトキシホスホリ 15 ル)メチル]フェニル、2-[(ジエトキシホスホリル) メチル〕フェニル、4-[(ジメトキシホスホリル)メ チル〕フェニル、4-〔(ジプロポキシホスホリル)メ チル〕フェニル、4-〔(ジイソプロポキシホスホリル) 20 メチル〕フェニル、4-〔(ジブトキシホスホリル)メ チル〕フェニル、4-[(ペンチルオキシホスホリル) メチル〕フェニル、4-〔(ジヘキシルオキシホスホリ

ル) メチル] フェニル、4-[2-(ジエトキシホスホ リル)エチル〕フェニル、4-〔3-(ジエトキシホス ホリル)プロピル〕フェニル、4-〔4-(ジエトキシ ホスホリル) ブチル] フェニル、4-[5-(ジエトキ シホスホリル)ペンチル]フェニル、4-[6-(ジエ 5 トキシホスホリル) ヘキシル〕フェニル、4 - 〔(エト キシフェニルホスホリル)メチル]フェニル、4-〔(メトキシフェニルホスホリル)メチル〕フェニル、 4-〔(フェニルプロポキシホスホリル)メチル〕フェ ニル、4-〔(ブトキシフェニルホスホリル)メチル〕 10 フェニル、4-[(ペンチルオキシフェニルホスホリル) メチル〕フェニル、4-[(ヘキシルオキシフェニルホ スホリル) メチル] フェニル、4-[(ベンジルオキシ エトキシホスホリル)メチル]フェニル、4-〔〔(4 - クロロベンジルオキシ)エトキシホスホリル〕メチル〕 15 フェニル、4-〔〔(3-クロロベンジルオキシ)エト キシホスホリル] メチル] フェニル、4 - 〔〔〔2-ク ロロベンジルオキシ) エトキシホスホリル〕メチル〕フ ェニル、4-〔(ジエトキシホスホリル)メトキシ〕フ ェニル、3-〔(ジエトキシホスホリル)メトキシ〕フ 20 ェニル、2-〔(ジエトキシホスホリル)メトキシ〕フ ェニル、4-[2-(ジエトキシホスホリル)エトキシ]

フェニル、4-[3-(ジェトキシホスホリル)プロポキシ]フェニル、<math>4-[4-(ジェトキシホスホリル)ブトキシ]フェニル、4-[5-(ジェトキシホスホリル)ペンチルオキシ]フェニル、<math>4-[6-(ジェトキシホスホリル)ペンチルオキシ]フェニル基等を例示できる。

本発明方法における一般式(1)で表わされる化合物 (出発物質)の環化反応は、該化合物に、不活性溶媒中、 塩基の存在下、ハロゲン化トリアルキルシランを作用さ 10 せることにより行なわれる。

ここで、不活性溶媒としては、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、石油エーテル等の芳香族乃至脂肪族炭化水素類、ジエチルエーテル等のエーテル類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2ージクロロメタン、クロロボルム、四塩化炭素、1,2ージクロロエチルアミン、N,Nージエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン等の3級アミンを好ましく使用しては、例えばクロロトリメチルシラン、クロロジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロブチルジメチルシラン、クロロアカル

ピルシラン、トリブチルクロロシラン、クロロエチルメ チルプロピルシラン等のクロロトリアルキルシランを好 適に使用できる。

上記ハロゲン化トリアルキルシラン及び塩基の使用量 は、特に限定されないが、一般に1~過剰当量、好まし くは3~20当量とするのがよく、反応は通常0~ 100℃で、0.5~20時間程度で完了する。

尚、本発明における出発物質は、例えば下記反応工程 式に示す方法により得ることができる。

10 反応工程式

15 (A) (C)

〔式中R¹、R²、R³、R⁴、R⁵及びR°は前記に同じ。Yはハロゲン原子を示す。〕

上記反応工程式において、化合物(A)と酸ハロゲン化物(B)との反応は、不活性溶媒中、脱酸剤の存在下で実施できる。不活性溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、石油エーテル等の芳香族炭化水素乃至脂肪族炭化水素類やジエチルエーテル等のエーテル類、ア

セトン、メチルエチルケトン、アセトフェノン等のケトン類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類等を使用できる。また脱酸剤としては、トリエチルアミン、N.

5 N - ジェチルアニリン、N - メチルモルホリン、ピリジン、4 - ジメチルアミノピリジン等のアミン類を好適に利用できる。

酸ハロゲン化物(B)の使用量は、化合物(A)に対して等モル量~少過剰量とし、脱酸剤の使用量は、化合10 物(A)に対して等モル量~過剰量とするのがよい。反応は、一般に0℃~室温付近の温度条件下に0.5~50時間程度を要して行ない得る。

かくして、本発明によれば容易に高収率で所望のキナ ゾリン-4-オン誘導体を収得できる。得られるキナゾ 15 リン-4-オン誘導体は、糖尿病治療剤などの医薬品合 成中間体として、またそれ自体糖尿病治療剤有効成分化 合物として有用である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を更に詳しく説明するため、本発明方法 20 に出発物質として利用する化合物の製造例を参考例とし て挙げ、次いで本発明方法の実施例を挙げる。

参考例 1

4 - 〔(ジエトキシホスホリル)メチル〕安息香酸27.2gをジクロロメタン60ml及びDMF2mlに懸濁させ、これに塩化チオニル13.1gを加えて1時間還流した。反応終了後、放冷した反応混合物を、2-(N-メチルカルバモイル)-5-クロロアニリン18.5gのピリジン50ml及びジクロロメタン30ml溶液中に、氷冷下撹拌しながらゆっくり滴下した。滴下終了後、室温で48時間撹拌し、反応混合物中に水50mlを加え、析出した結晶を濾取し、水で充分洗浄10後、乾燥して、ジエチル4-{〔5-クロロ-2-(N-メチルカルバモイル)フェニル〕カルバモイルトベンジルホスホナート23.6gを得た。

実施例 1

参考例1で得られた化合物80g(182. 3 mmo1) 15 をトリエチルアミン221g(2184. 0 mmo1)とジ クロロメタン2000mlに溶かし、室温下に撹拌しな がらクロロトリメチルシラン87g(800. 8 mmo1) をゆっくり滴下した。 滴下終了後、40℃で17時間加 熱撹拌した。 反応終了後、反応混合物を濃縮し、残渣に 20 1規定塩酸1000mlを加え、ジクロロメタンで抽出 した。 有機層を硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下 に溶媒を留去した。残留物にジイソプロピルエーテルを 加えて結晶化させ、結晶を濾取した。 粗結晶をエタノールー水より再結晶して、目的とするジエチル 4-(7-2-2-4-4) ベンジルホスホナート88.6 gを得た。

5 実施例 2~13

参考例1及び実施例1と同様にして、第1表及び第2 表に記載の各化合物を製造した。各表には、各化合物の 構造、融点及び収率を記載する。

尚、表中Meはメチル基を、Etはエチル基を、Ph 10 はフェニル基を示す。

		~
表	2 ² 2	
-		
無		- 8∼
	Z.Z. Z.Z.	

(%)	6 3	9 9	8 1
融点 (°C)	142~142.5	73~74	143~144
R ⁶	$^{0}_{-\mathrm{CH}_2-\mathrm{P}(\mathrm{OEt})_2}$	0 -CH ₂ -P (OEt) ₂	0 -CH ₂ -P (OEt) ₂
R ⁵	Me	១	Me
R 4	Ħ	E.	Н
R ³ R ⁴	C 1	. Н	H
R ²	H	B r	I
R	H	-	王
実施例	-	. 2	က

第 1 表 (続き

	1	 		,	7	ī	
(%) 奉劢	8 3	8 52	6 3	7 8	6 5	8 9	6 9
融点 (で)	238~239	116~117	$135 \sim 136$	157~158	81.5~82.5	125~126	192~193
R ⁶	0 -CH ₂ -P(OEt) ₂	0 -CH ₂ -P(OEt) ₂	Н	Н	Н	Me	-CH ₂ -P-Ph 06t
R 5	M e	Ме	Me	Рһ	-CII ₂ -CII=CII ₂	M e	Me
R 4	エ	五	H	H	H	H	王
R ³	McN-C- II II	Me-0-C-	H	H	Н	C 1	C 1
R ²	1	Ħ	H	H	1:1	Н	H
R	Ξ		Ξ	Ξ	Ξ	=	=
実施例	7	5	9	2	8	6	0 -

表	-X-R5	
73		₹.
紙	22	

		1	
(%) 奉劢	7 3	7.2	7 1
₩点 (℃)	146~147	183~184.5	102.5~103.5
R ⁶	CF_3	Me	Me - COOE t
R ⁵	ча	P h	M _e
R ⁴	Н	. H	H
R ³		H	Н С1
R ² R ³ R ⁴ R ⁵	Вг	С1 Н	H
R 1	H Br H	H	Н
実施例 R 1	1 1	1.2	. 13

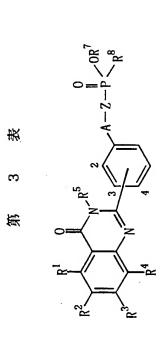
実施例14~49

参考例1及び実施例1と同様にして、第3表及び第4 表に記載の各化合物を高収率で製造することができる。 尚、表中Me、Et及びPhは前記に同じであり、 iPrはイソプロピル基を、Acはアセチル基をそれぞれ示す。

10

5

15



融点 (°C)	144~ 145	177~ 178	$\begin{array}{c} 121 \\ 122 \end{array}$
結合 位置	4	. 4	. 4
2	CH_2	CH2	CH2
A	単結合	単結合	単結合
R ⁸	OE t	OE t	OE t
R 7	E t	E t	r I
R ⁵	Me	Me	Me
R ⁴	Н	H	H
R 3	C 1	NO2	CN
R ²	B r	Вг	I
R 1	Ξ	Ξ	I
実 何 何	14	1.5	1 6

第 3 表 (続き)

	 .			**		
融点 (°C)	10.9° 11.0	116~ 119	117~ 118	66.5~ 67.5	油状物 NMR(1)	苗状物 NMR (2)
在 位 面	4	4	4	4	4	4
2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH2	C ₂ H ₄
<	単結合	単結合	単結合	単結合	単結合	0
R 8	ОМе	OiPr	OE t	OE t	OE t) 3O
R 7	Me	i P r	E t	E t	त t	면 t
R ⁵	. We	Me	Me	Me	Me	M e
R4	Н	H	н	I	五	H
R 3	C 1	C 1	ж.	C 1	C 1	C 1
R 2	H	H	Me	7	Ŧ	五
R 1	H	- 1-	H	I .	1:1	Ξ
多 多	17	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2

第 3 表 (続き)

融点 (℃)	143~ 144	油状物 NMR (3)	26~96	$9.9 \sim 100.5$	51~52	$\frac{156}{156.5}$
結 位 置	4	4	4	4	4	4
2	CH2	CH_2	CH_2	CH2	CH2	CH2
K	単結合	単結合	単結合	単結合	単結合	単結合
R 8	-0 CH ₂ \bigcirc \bigcirc C ₁	-OCH ₂ Ph	OE t	OE t	OE t	OE t
R 7	. ह्य	छ t	E t	豆 t	E t	ਸ t
R 5	Me	Me	-CH ₂ Ph	Me	M e	РЪ
R	Н	H	H	ОМе	工	Ξ
R 3	C.1	C 1	H	H	-CF3	H
R ²	H	I	H	H	Ξ	Н
٦ ا	H	1:1	Ţ	Ξ	Ξ	H
突施	2 3	2.4	2 5	26	2.7	2 8

第 3 表 (続き

屬点 ('C)	$103 \sim 104$	$123\sim$ 124	143~ 146	$10.9 \sim 11.0$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
括 百 個	4	4	. 4	4	4
2	CH2	CH2	CH2	CH2	CH_2
А	単結合	申結合	単結合	単結合	単結合
8 N.	OE t	OE t	OE t	OM e	OE t
R 7	E t	E t	Εt	Me	E t
R 5		-OCH2OMe	CH ₂ CH ₂ CH	Ме	Me M
R4	H	Ξ	H	H	Ţ
R 3	ОМе	C 1	C 1	C 1	NO2
R 2	ОМе	Ξ	Ţ	Ξ	Η
- ~	=	Ξ	Ξ	=	Ξ
发施	2 9	3.0	3.1	3.2	3 3

第 3 表(続き)

実施例	¹ H-NMR (δ:ppm) (CDCl ₃)
2 1	1. 18 (6H, dt, J=4, 7) 3. 08 (1H, dd, J=22, 15) 3. 44 (3H, s), 3. 67 (1H, dd, J=22, 15) 3. 90-4. 02 (4H, m), 7. 32-7. 59 (5H, m) 7. 69 (1H, d, J=2), 8. 28 (1H, d, J=9)
2 2	1. 37 (6H, t, J=7) 2. 35 (2H, dt, J=19, 7) 3. 52 (3H, s), 4. 11-4. 20 (4H, m) 4. 27-4. 37 (2H, m), 7. 04 (2H, d, J=9) 7. 43 (1H, dd, J=8, 2), 7. 53 (2H, d, J=9) 7. 71 (1H, d, J=2), 8. 24 (1H, d, J=8)
2 3	1. 25 (3H, t, J=7), 3. 23 (2H, d, J=22) 3. 47 (3H, s), 3. 94-4. 15 (2H, m) 5. 04 (2H, d, J=9), 7. 35-7. 52 (10H, m) 7. 71 (1H, d, J=2), 8. 23 (1H, d, J=9)

	R ₂	
表	Z- 0=	-\(\)z
4		<u></u> _
寒	~==	=<

	2	. ന	7	5	ည	က
融点 (°C)	$164.5 \sim 165.5$	217 ~ 218.	156~157	$200.5 \sim 222.5$	155 156.	116.5 117.
R 6	-COOE t	Me	Me	Me	M e	M ©
R 5	Рһ	OM e OM e	P h	P h	C1	M e
R 4	H	Н	H	Η	Н	H
R 3	H	1-1	Н	H	FI	Ξ
R ²	Вг	Вг	1	NO2	Вr	1-1
٦-	1:1	F.I.	F-1	Ξ	Н	=
実施例	34	3 5	3.6	3.7	3 8	3.9

第 4 表 (続き)

融点 (℃)	191. $5 \sim 192.5$	238~239.5	$216.5 \sim 217.5$	191. $5 \sim 193$	250以上	$1.91.5 \sim 1.92.5$	173~174	$180.5 \sim 182$	163~164.5	$120 \sim 122$
. ₉ 신	M e	Me	Me	. Me	Me	Me	Me	Me	$-CH_2-CI$	CF3
R 5	РЪ	P h	P h	Ph	P h	P h	Рh	Ча	M e	Me
R 4	C 1	C 1	C 1	Н	Н	H	Ξ	H	H	Н
R ³	·H	C 1	C 1	C 1	Ξ	Н	C 1	H	C 1	C 1
R2	C 1	H	C -	C 1	Ξ	A c 0	=	Вг	1-1	I
R 1	Ξ	H	Ξ	H	C 1	H	Ξ	Ξ	Ξ	I
実施例	4.0	4 1	4.2	1 3	ドド	4.5	16	17	2 8	4.9

請求の範囲

1. 一般式

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & 0 \\
NH - R^5 \\
0 & R^6
\end{array}$$

〔式中R¹、R²、R³及びR⁴は同一又は異なって水素原 子、低級アルキル基、ハロゲン原子、ニトロ基、低級 10 アルコキシ基、シアノ基、N-低級アルキルカルバモ イル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルカノ イルオキシ基又はハロゲン置換低級アルキル基を、R5 は置換基として低級アルキル基、低級アルコキシ基及 びハロゲン原子から選ばれる基の1~3個を有するこ 15 とのあるフェニル基、低級アルキル基、フェニル環上 に置換基としてハロゲン原子を有することのあるフェ ニル低級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルコ キシ低級アルキル基又は低級アルキニル基を、R°は低 級アルキル基、ハロゲン置換低級アルキル基、低級ア 20 ルコキシカルボニル基又は置換基として低級アルキル 基もしくは基

$$-A-Z-P < \frac{0}{R^8}$$

(式中Aは酸素原子又は単結合を、 2 は低級アルキレン 基を、 R 'は低級アルキル基を、 R ®は低級アルコキシ 基、フェニル基又はフェニル環上にハロゲン原子を有することのあるフェニル低級アルコキシ基を表す)を 有することのあるフェニル基をそれぞれ示す。〕

で表される化合物に、塩基の存在下、ハロゲン化トリア 10 ルキルシランを作用させて環化反応を行なうことを特徴 とする、一般式

15

〔式中R¹、R²、R³、R⁴、R⁵及びR°は上記に同じ。〕で表されるキナゾリン-4-オン誘導体の製造方法。

- 2. 塩基が3級アミンである請求項1に記載の方法。
- 20 3. ハロゲン化トリアルキルシランがクロロトリアル キルシランである請求項1又は2に記載の方法。
 - 4. 塩基及びハロゲン化トリアルキルシランの使用量

が、それぞれ3~20当量である請求項1~3のいずれかに記載の方法。

反応温度が、0~100℃である請求項1~4のいずれかに記載の方法。

5

10

15

20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/02388

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER							
Int	. C1 ⁶ C07D239/90, C07D239/	91					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	DS SEARCHED						
	ocumentation searched (classification system followed b	•					
Int.	. C1 ⁶ C07D239/90, C07D239/9	91					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
	ata base consulted during the international search (name ONLINE	of data base and, where practicable, search t	erms used)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	JP, 2-282378, A (Japan Syntheta.),	thetic Rubber Co.,	1 - 5				
	November 19, 1990 (19. 11. Claim (Family: none)	90),					
	Claim (ramily: none)						
	·						
			ļ				
		·					
			•				
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" docume							
	earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be						
cited to	L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other						
	means combined with one or more other such documents, such combination						
	nt published prior to the international filing date but later than ity date claimed	being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family					
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report				
Nove	ember 11, 1996 (11. 11. 96)	November 19, 1996	(19. 11. 96)				
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer					
Japa	nese Patent Office						
Facsimile No	o.	Telephone No.					

国際出願番号 PCT/JP96/02388

A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		· ·
Int	c 1 ° C 0 7 D 2 3 9 / 9 0, C 0 7 D 2 3 9	/91	
D 502-4- + /	- 1./1 W7		
	行った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Ì	·		
Int	c 1 ° · C 0 7 D 2 3 9 / 9 0, C 0 7 D 2 3 9	91	
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		**************************************
	1 - 211 - 112 - 11 - 112 - 11 - 112 -	٠.	
	•		•
			·
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	、調査に使用した用語)	
CAS	ONLINE		
		•	
C. 関連する			
引用文献の	3 と説の 54 に3 大風		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP, 2-282378, A (日本合成ゴム (19.11.90)特許請求の範囲 (フ		1 – 5
		·	·
		·	
	hand desired the second of the		447 > 44.57
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。 	パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
* 引用文献の	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
	重のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	
もの 「F + 先行文庫	試ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	て出願と矛盾するものではなく、 論の理解のために引用するもの	、発明の原理又は埋
· 33 次ii 入ii	A CIOSON Y EMILIANDO AND THE O	「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	
	くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって	
「〇」口頭に。	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	
「P」国際出源	領日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完	アレた日 11.11.96	国際調査報告の発送日 19	.11.96
	and the second		
	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	4 C 8 6 1 5
	野便番号100	Line in	
	邓千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	電話番号 03-3581-1101	内線 3452